	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP021	文件编号	XS-W-091
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XP021 芯片封装的成品管主要适用于音频功放电路。

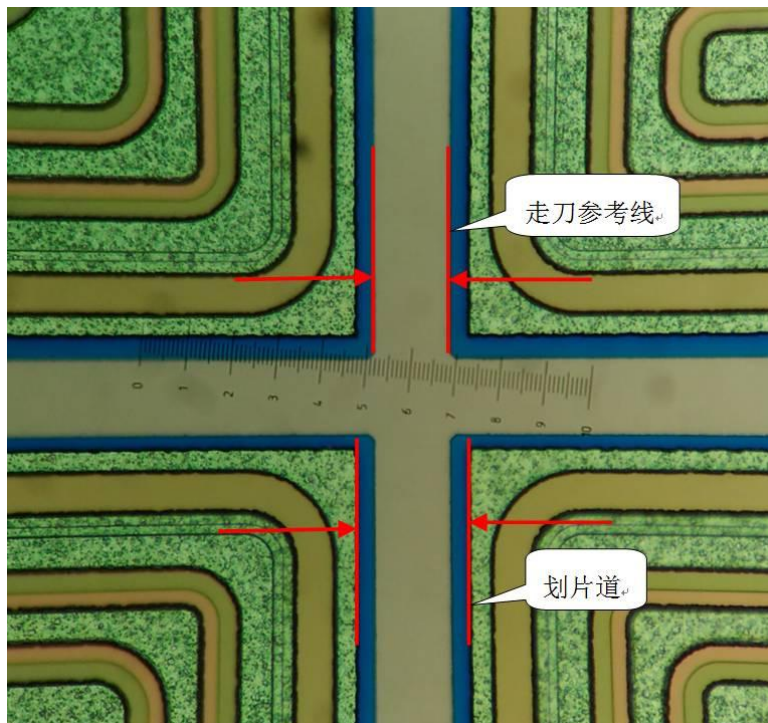
1.2 主要特点

- 饱和压降低
- 击穿电压高

2 芯片数据


芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.74×0.74		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20		
	划片道*尺寸 (μm)	40		
	键合区面积 (μm ²)	基区	120×140	
		发射区	120×140	
	钝化层	Si ₃ N ₄		
	正面电极	金属	铝	
		厚度 (μm)	3.0±0.5	
	背面电极金属	金		
	硅片直径 (mm)	φ125		
	装片要求 (推荐)	共晶		
	键合要求 (推荐)	铜丝; φ42 μm; E、B 区各一根		

* 划片道位置示意图:



备注: 划片道**两侧**的铝条不断裂即判为合格。

江阴新顺微电子有限公司	
地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号	网 址: http://www.xs-elec.com
电 话: (0510) 86851182	传 真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP021	文件编号	XS-W-091
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	2/3

3 电特性 (在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

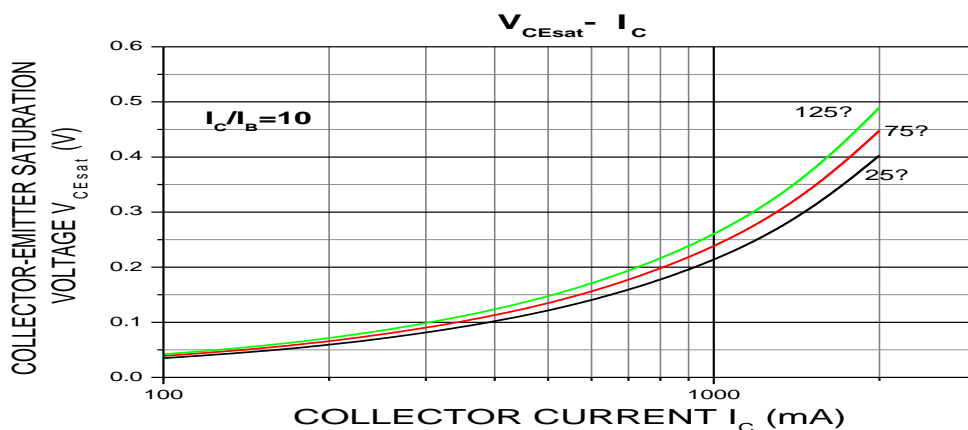
参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	-50	V	推荐封装形式: T0-92L 推荐成品型号: 3CG8551
集电极-发射极电压	V_{CE0}	-40	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	-5	V	
集电极电流	I_C	-2	A	
耗散功率 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	-0.9	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB} = -50\text{V}, I_E = 0$			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$			-0.1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_E = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	100		320	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C = -1\text{A}, I_B = -100\text{mA}$			-1	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -10\text{V}, I_C = -50\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$	150			MHz

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>

传真: (0510) 86851532



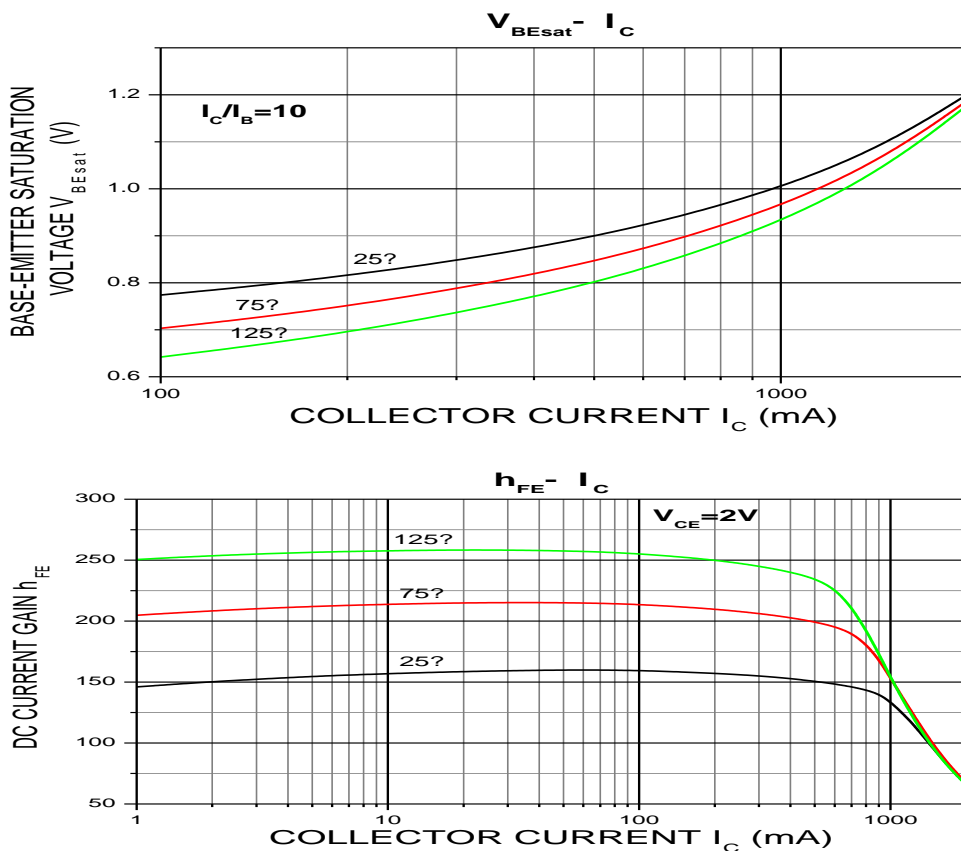
江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XP021

高频放大环境额定双极型晶体管

文件编号 XS-W-091

版本号 18-B1-06

页码 3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532